

## **ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ**

Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука" (Санкт-Петербург)

Том: 51 Номер: 2 Год: 2017

<b>ОСОБЕННОСТИ ЗОННОЙ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЗМОВ ПРОВОДИМОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКА N-HFNISN, СИЛЬНО ЛЕГИРОВАННОГО Y</b>	147-153
<i>Ромака В.А., Rogl P., Ромака В.В., Kaczorowski D., Крайовский В.Я., Стаднык Ю.В., Горынь А.М.</i>	
<b>ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕНОСА В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ МАТЕРИАЛОВ ФАЗОВОЙ ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ КВАЗИБИНАРНОГО РАЗРЕЗА GETE-SB2TE3</b>	154-160
<i>Шерченков А.А., Козюхин С.А., Лазаренко П.И., Бабич А.В., Богословский Н.А., Сагунова И.В., Редичев Е.Н.</i>	
<b>ТЕРМОЭДС И ТЕРМОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ERX SN1-X SE</b>	161-165
<i>Гусейнов Д.И., Мургузов М.И., Исмаилов Ш.С., Мамедова Р.Ф., Годжаев Э.М.</i>	
<b>ПОЛЕВАЯ ДИФФУЗИЯ В НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ В УСЛОВИЯХ ЗАПОЛНЕНИЯ ГЛУБОКИХ СОСТОЯНИЙ</b>	166-171
<i>Никитенко В.Р., Кудров А.Ю.</i>	
<b>МАГНИТОЗАВИСИМОЕ МИКРОВОЛНОВОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ В HGSE В СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ</b>	172-176
<i>Вейнгер А.И., Тиснек Т.В., Кочман И.В., Окулов В.И.</i>	
<b>КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА В INP, ЛЕГИРОВАННОМ ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ VE+</b>	177-181
<i>Авакянц Л.П., Боков П.Ю., Червяков А.В.</i>	
<b>ВЛИЯНИЕ ТИПА И СТЕПЕНИ ЛЕГИРОВАНИЯ НА МОРФОЛОГИЮ POR -SI, ПОЛУЧЕННОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ТРАВЛЕНИЕМ</b>	182-186
<i>Пятилова О.В., Гаврилов С.А., Шиляева Ю.И., Павлов А.А., Шаман Ю.П., Дудин А.А.</i>	
<b>ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО ИОНАМИ ЦИНКА И ОТОЖЖЕННОГО В КИСЛОРОДЕ</b>	187-192
<i>Привезенцев В.В., Кириленко Е.П., Горячев А.Н., Батраков А.А.</i>	
<b>ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСАЖДЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО КРАСИТЕЛЯ РОДАМИН Б НА ПОВЕРХНОСТЬ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ С РАЗЛИЧНЫМ РАЗМЕРОМ ПОР</b>	193-197
<i>Леньшин А.С., Середин П.В., Кавецкая И.В., Минаков Д.А., Кашкаров В.М.</i>	
<b>СПЕКТРЫ ЭЛЕКТРООТРАЖЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ КВАНТОВЫХ ЯМ INGAN/GAN, ПОМЕЩЕННЫХ В НЕОДНОРОДНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ P-N-ПЕРЕХОДА</b>	198-201
<i>Авакянц Л.П., Асланян А.Э., Боков П.Ю., Положенцев К.Ю., Червяков А.В.</i>	
<b>НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПОЛУПРОВОДНИКА НА ИНТЕРФЕЙСЕ С ОРГАНИЧЕСКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ</b>	202-204
<i>Яфясов А.М., Божевольнов В.Б., Рюмцев Е.И., Ковшик А.П., Михайловский В.Ю.</i>	
<b>ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ АМОРФНЫХ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕМНИЕВЫХ НАНОКЛАСТЕРОВ В СВЕРХРЕШЕТКАХ ИЗ НИТРИДА И ОКСИДА КРЕМНИЯ</b>	205-211
<i>Шулейко Д.В., Заботнов С.В., Жигунов Д.М., Зеленина А.А., Каменских И.А., Кашкаров П.К.</i>	
<b>ЗАРОЖДЕНИЕ ДВУМЕРНЫХ ОСТРОВКОВ НА SI(111) ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ЭПИТАКСИАЛЬНОМ РОСТЕ</b>	212-215
<i>Ситников С.В., Косолобов С.С., Латышев А.В.</i>	
<b>СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ ZNS : CU (5 AT%) В ПОРИСТОМ AL2O3 РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ</b>	216-221
<i>Валеев Р.Г., Тригуб А.Л., Чукавин А.И., Бельтюков А.Н.</i>	
<b>ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК МАЛОГО ДИАМЕТРА</b>	222-225
<i>Подливаев А.И., Опенов Л.А.</i>	

<b>К ТЕОРИИ АДСОРБЦИИ НА ГРАФЕНОПОДОБНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ</b> <i>Давыдов С.Ю.</i>	226-233
<b>АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОМЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ НА ОТПИРАЮЩИЙ ТОК УПРАВЛЕНИЯ ТИРИСТОРНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ 4H-SiC</b> <i>Юрков С.Н., Мнацаканов Т.Т., Левинштейн М.Е., Тандолев А.Г., Paltour J.W.</i>	234-239
<b>ВЛИЯНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ УТЕЧКИ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ КВАНТОВОГО ВЫХОДА СВЕТОДИОДОВ НА ОСНОВЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ КВАНТОВЫХ ЯМ INGAN/GAN</b> <i>Прудаев И.А., Копьев В.В., Романов И.С., Олейник В.Л.</i>	240-246
<b>ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР INAS/INAs(SB)/INASSBP В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 4.2-300 К</b> <i>Мынбаев К.Д., Баженов Н.Л., Семакова А.А., Михайлова М.П., Стоянов Н.Д., Кижяев С.С., Молчанов С.С., Астахова А.П., Черняев А.В., Lipsanen H., Бугров В.Е.</i>	247-252
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРОГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТПИРАНИЯ СИЛОВЫХ GAN-ТРАНЗИСТОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ В ПОТОКЕ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА</b> <i>Ерофеев Е.В., Федин И.В., Кутков И.В., Юрьев Ю.Н.</i>	253-257
<b>МПМ ДЕТЕКТОР ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН НА СВЕРХРЕШЕТКЕ ZNSE/ZNTE ВТОРОГО ТИПА</b> <i>Кузнецов П.И., Аверин С.В., Житов В.А., Захаров Л.Ю., Котов В.М.</i>	258-262
<b>ОСОБЕННОСТИ ВОЛНОВОДНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ В ЛАЗЕРНЫХ СТРУКТУРАХ С АСИММЕТРИЧНЫМИ БАРЬЕРНЫМИ СЛОЯМИ</b> <i>Полубавкина Ю.С., Зубов Ф.И., Моисеев Э.И., Крыжановская Н.В., Максимов М.В., Семенова Е.С., Yvind K., Асрян Л.В., Жуков А.Е.</i>	263-268
<b>ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ВО ФЛИП-ЧИП ФОТОДИОДАХ НА ОСНОВЕ ДВОЙНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР INASSBP/INAs</b> <i>Закгейм А.Л., Ильинская Н.Д., Карандашев С.А., Лавров А.А., Матвеев Б.А., Ременный М.А., Стусь Н.М., Усикова А.А., Черняков А.Е.</i>	269-275
<b>ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОЕВ GaP(N), СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИИ НА ПОДЛОЖКАХ Si(100) 4<sup>o</sup></b> <i>Крыжановская Н.В., Полубавкина Ю.С., Неведомский В.Н., Никитина Е.В., Лазаренко А.А., Егоров А.Ю., Максимов М.В., Моисеев Э.И., Жуков А.Е.</i>	276-280
<b>THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE CONDUCTIVITY PEAK VALUES IN THE SINGLE AND THE DOUBLE QUANTUM WELL NANOSTRUCTURES IN-GAAS/GAAS AFTER IR-ILLUMINATION</b> <i>Arapov Yu.G., Gudina S.V., Klepikova A.S., Neverov V.N., Harus G.I., Shelushinina N.G., Yakunin M.V.</i>	281